

Дифференцируя  $\omega_2$  по  $H$ , установим, что на плоскости  $(\omega, H)$  ветвь  $\omega_2(H)$  имеет минимум в точке  $(\omega_{2\min}, H_{2\min})$

$$H_{2\min} = H_c(1 - b \sin \psi); \quad \omega_{2\min}^2 = 2(\gamma H_c)^2 \frac{(r-1)(1+b^2) \sin \psi}{(r+1)(1+b^2)^{1/2} + 2b}, \quad (15)$$

$$b = (2q)^{-1} [ - (q+3) + \sqrt{(q+3)^2 + 4q}], \quad q = \left(\frac{r+1}{2}\right)^2 - 1. \quad (16)$$

Возникновение минимума у нижней ветви  $\omega_2(H)$  соответствует резонансной диаграмме двухосного АФМ в закритической области  $\psi > \psi_k$  (см. рис. 3 работы [24]). При фиксированной частоте  $\omega$  ВЧ поля из выражений (15) определяются  $\psi = \psi_f$  и поле срыва АФМР  $H = H_f$ , т. е. значения  $\psi$  и  $H$ , при которых частота соответствует минимуму кривой  $\omega_2(H)$ . Как  $\psi_f$ , так и  $(H_f - H_n)$  пропорциональны  $\omega^2$ . Разрешая (14) относительно  $\sin^2 \psi$ , получаем

$$\begin{aligned} \sin^2 \psi_{1,2} = \frac{1}{4} \left\{ \frac{\omega_0^4}{2} \left( \frac{r+1}{r-1} \right)^2 + 2 \frac{\omega_0^2(1-z)}{r-1} - (1-z)^2 \pm \right. \\ \left. \pm \omega_0^3 \frac{r+1}{r-1} \sqrt{\frac{\omega_0^2(r+1)^2}{4(r-1)^2} + 2 \frac{1-z}{r-1}} \right\}. \end{aligned} \quad (17)$$

Выражение (17) в силу сделанных приближений не описывает детально поведения резонансных диаграмм, связанного с изменениями  $\Delta H < 0,1$  кэ и  $\Delta \psi < 1^\circ$ , однако в области, где

$$H^2 < H_n^2 \left( 1 + \frac{\omega_0^2(r+1)^2}{8(r-1)} \right), \quad \omega_0 = \frac{\omega}{\gamma H_n}, \quad (18)$$

оно дает простое и качественно правильное описание таких диаграмм.

### Сравнение теории с экспериментом

Проведем это сравнение сначала для  $T = 1,68^\circ\text{K}$ .

Систематическое возрастание резонансных полей с увеличением давления, экспериментально наблюдаемое в  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , находится в удовлетворительном согласии с теоретическими зависимостями. Приняв  $H_{1p} = H_{||}^{(p)}$  и  $H_{2p} = H_n$  ( $H_n$  — поле фазового перехода  $l_{||} \rightleftharpoons l_\perp$ ), сравним (8) — (11) с экспериментальными данными. Предположив, что  $\lambda_z'' \gg \lambda_y''$ , с учетом  $H_1(p, T) \approx H_n(p, T)$  представим эти выражения в виде, удобном для сравнения с экспериментом:

$$H_{1p} = \left[ H_n^2(p, T) - \gamma^{-2} \omega^2 \frac{r_0 + 3 + (A_3 + 3A_2)p}{r_0 - 1 + (A_3 - A_2)p} \right], \quad (19)$$

$$H_{2p} = H_n(p, T) = H_n(T) \sqrt{(1 + A_1 p)(1 + A_2 p)}, \quad (20)$$

$$\text{где } A_1 \approx \lambda_z'' \delta^{-1} \approx A_4, \quad A_2 = \lambda_y'' \beta_0^{-1}, \quad A_3 = \lambda_x'' \beta_0^{-1}, \quad r_0 = \beta_0 \rho_0^{-1}.$$

Используя экспериментальные значения  $H_{2p}$  ( $p = 11,2$  и  $5,2$  кбар) и  $H_{1p}$  ( $p = 11,2$  кбар) при  $\gamma = 3$  Гц и  $T = 1,68^\circ\text{K}$ , а также значение  $r_0 = 2,9$  [16], найдем  $A_1 \approx A_2 \approx 0,022$  кбар $^{-1}$ ,  $A_3 = 0,3$  кбар $^{-1}$ . Учитывая значение  $\delta_0 = \chi_\perp^{-1} = 2 \cdot 10^{-3}$  и  $\rho_0 \approx 6,5$  [17] для  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , найдем  $\lambda_z'' = 44$  кбар $^{-1}$ ,  $\lambda_y'' = 0,14$  кбар $^{-1}$ ,  $\lambda_x'' = 2$  кбар $^{-1}$ . Поскольку  $T_N \sim \delta$ ,  $T_N$  зависит от давления. Найденные значения  $\lambda_y''$  и  $\lambda_x''$  хорошо согласуются с оценочными значениями магнитоупругих постоянных  $\lambda \sim (1 \div 10^{-3})$  кбар $^{-1}$ , в то время как значение  $\lambda_z''$  на порядок превышает их максимальную оценку, что обусловлено, видимо, большей чувствительностью обменных взаимодействий к уменьшению межатомных расстояний при увеличении давления по сравнению с релятивистскими. В результате проведенного нами учета зависимости

обменного параметра  $\delta$  от давления полученные нами и авторами [17] значения  $\lambda_y''$  и  $\lambda_x''$  несколько различаются, однако порядки этих величин остались прежними. Теоретические зависимости  $H_{2p}(p)$ ,  $H_{1p}(p)$ , построенные согласно (19) и (20) при найденных значениях  $\lambda_z'', \lambda_y'', \lambda_x''$ , представлены на рис. 3 и находятся в согласии с экспериментальными данными. Они хорошо передают уменьшение разности  $H_{2p} - H_{1p}$  и увеличение резонансных полей  $H_{1p}$  и  $H_{2p}$  с увеличением давления  $p$ . Сравним теперь экспериментальные зависимости  $\psi_f$  и поля срыва АФМР  $H_f$  от давления и частоты с теоретическими. Как следует из (15), теоретические зависимости этих величин можно представить в виде

$$H_f = H_n [1 - B\omega^2 (\gamma H_n)^{-2}], \quad \psi_f = A\omega^2 (\gamma H_n)^{-2}, \quad (21)$$

где коэффициенты  $B(p)$  и  $A(p)$  легко находятся из (15). При сравнении (21) с экспериментом необходимо учесть, что параметр  $r$  зависит от давления следующим образом:

$$r = (r_0 + A_3 p) (1 + A_2 p). \quad (22)$$

Теоретические изохронные и изобарные зависимости представлены на рис. 3 и 4 и удовлетворительно описывают эксперимент. В частности, первая формула (21) хорошо описывает уменьшение разности  $H_n - H_f$  с увеличением давления.

Сравним теперь выражение (17) с данными эксперимента. Подставляя в (17) значения  $H_n(p, T)$  вместо  $H_n$  и учитывая зависимость  $r$  от давления (22), убеждаемся, что в области (18) выражение (17) достаточно хорошо количественно описывает зависимость  $H_p(\phi)$  на частотах 4,5—4,88 ГГц при давлениях вплоть до  $p \approx 5$  кбар.

Наконец, учитывая (2), (20) и равенство  $A_1 = A_2$ , находим, что величина интервала  $\Delta H = H' - H_n = 4\pi H_n \chi_\perp$ , в котором промежуточное состояние термодинамически стабильно, в пределах точности расчета не зависит в  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  от давления.

Прежде чем проводить дальнейшее сравнение теории с экспериментом, уточним природу наблюдаемого поглощения при  $p = 0$ . Величины большего резонансного поля на частоте  $\nu_2 = 3,14$  ГГц и резонансного поля на частоте  $\nu_1 \approx 0,7$  ГГц равны  $H_{p\nu_2} \approx H_{p\nu_1} \approx H_n = 6,7$  кэ при  $\phi = 0$  и соответствуют значению поля фазового перехода  $l_{||} \rightleftharpoons l_\perp$  при  $T = 1,68^\circ\text{K}$  [25], вследствие чего можно сделать вывод, что они обусловлены поглощением в промежуточном состоянии (ПС), подробно проанализированном в [16]. Меньшие резонансные поля на частотах  $\nu_2 = 3,14$  ГГц и  $\nu_3 = 4,88$  ГГц лежат в области, где  $H_p < H_n$ , и обусловлены поглощением в однородной фазе  $l_{||}$ . Сложнее объяснить природу поглощения в большем резонансном поле на частоте  $\nu_3 = 4,88$  ГГц. При значениях угла  $\phi$ , близких к нулю, наблюдаемая экспериментально резонансная линия становилась настолько слабой, что ее положение нельзя было надежно определить. Для выяснения природы этой линии определим по формулам (20), (21) работы [16] значение поля  $H_2(T)$ , ограничивающего снизу область устойчивости однородной фазы  $l_\perp$ . Как видно из рис. 1, поле, соответствующее максимуму изогоны  $\nu_3 = 4,88$  ГГц, равно  $H_m = 6,82$  кэ. Принимая  $H_\nu = \gamma^{-1}\nu = 0,33$  кэ (для  $\nu$  в ГГц),  $H_{p0} = 6,5$  кэ, находим  $H_2 = 6,53$  кэ при  $T = 1,68^\circ\text{K}$ . Резонансное поле для фазы  $l_\perp$  на частоте 4,88 ГГц находится в пределах  $H_{2p} = 6,73$  кэ  $> 6,70$  кэ  $= H_n$ . Интервал  $\Delta H = H' - H_n = 4\pi \chi_\perp H_n$  реализации ПС в области  $T \ll 1,68^\circ\text{K}$  мало изменяется и по теоретической оценке составляет около 40 э [16]. Этот интервал охватывает участок нижней резонансной ветви однородной фазы  $l_\perp$ , заключенный между частотами  $\omega_\perp(H_n) = 4,62$  ГГц  $< \omega < \omega_\perp(H') = 5,03$  ГГц. В тех же интервалах частот и полей существует ветвь резонансного поглощения, обусловленная промежуточным